

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 1 部門第 2 区分

【発行日】平成 24 年 8 月 30 日 (2012.8.30)

【公開番号】特開 2008-86766 (P2008-86766A)

【公開日】平成 20 年 4 月 17 日 (2008.4.17)

【年通号数】公開・登録公報 2008-015

【出願番号】特願 2007-253093 (P2007-253093)

【国際特許分類】

A 6 1 B 5/055 (2006.01)

G 0 1 R 33/385 (2006.01)

【F I】

A 6 1 B 5/05 3 4 0

G 0 1 N 24/06 5 1 0 Y

【手続補正書】

【提出日】平成 24 年 7 月 13 日 (2012.7.13)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

磁気共鳴撮像システムの傾斜コイル (3 0 0、4 0 0) であって、
第 1 の表面 (3 1 6、4 1 6) 及び第 2 の表面 (3 1 8、4 1 8) を有する銅からなる少なくとも 1 つの層 (3 0 2、4 0 2) と、
前記銅層 (3 0 2、4 0 2) の第 1 の表面 (3 1 6、4 1 6) に付着させた第 1 の半導体層 (3 1 4、4 1 4) と、
前記第 1 の半導体層 (3 1 4、4 1 4) に付着させた絶縁層 (4 0 4) と、
を備える傾斜コイル (3 0 0、4 0 0)。

【請求項 2】

前記銅 (3 0 2、4 0 2) は、シート、中実丸形導体、中空導体またはワイヤのうちの 1 つとして形成されている、請求項 1 に記載の傾斜コイル (3 0 0、4 0 0)。

【請求項 3】

さらに、前記銅 (3 0 2) の第 2 の表面 (3 1 8) に付着させた第 2 の半導体層 (3 1 2) を備える請求項 1 に記載の傾斜コイル (3 0 0、4 0 0)。

【請求項 4】

さらに、前記第 2 の半導体層 (3 1 2) に付着させた積層物層 (3 0 6) を備える請求項 3 に記載の傾斜コイル (3 0 0、4 0 0)。

【請求項 5】

前記絶縁層 (4 0 4) はエポキシ樹脂である、請求項 1 に記載の傾斜コイル (3 0 0、4 0 0)。

【請求項 6】

磁気共鳴撮像システムの傾斜コイル (3 0 0、4 0 0) を製作する方法であって、
銅層 (3 0 2、4 0 2) の第 1 の表面 (3 1 6、4 1 6) に第 1 の半導体層 (3 1 4、4 1 4) を付着させる工程 (2 1 0) と、
前記銅層 (3 0 2、4 0 2) の第 2 の表面 (3 1 8、4 1 8) に第 2 の半導体層 (3 1 2) を付着させる工程 (2 1 2) と、
前記第 2 の半導体層 (3 1 2) に積層物層 (3 0 6) を付着させる工程 (2 1 4) と、

前記第１の半導体層（３１４、４１４）に絶縁層（４０４）を付着させる工程（２１６）と、
を含む方法。

【請求項７】

銅層（３０２、４０２）の第１の表面（３１６、４１６）に第１の半導体層（３１４、４１４）を付着させる前記工程は、銅層（３０２、４０２）の第１の表面（３１６、４１６）に第１の半導体層（３１４、４１４）を積層させる工程を含む、請求項６に記載の方法。

【請求項８】

銅層（３０２、４０２）の第２の表面（３１８、４１８）に第２の半導体層（３１２）を付着させる前記工程は、銅層（３０２、４０２）の第２の表面（３１８、４１８）に第２の半導体層（３１２）を積層させる工程を含む、請求項６に記載の方法。

【請求項９】

第２の半導体層（３１２）に積層物層（３０６）を付着させる前記工程は、第２の半導体層（３１２）に積層物層（３０６）を積層させる工程を含む、請求項６に記載の方法。

【請求項１０】

第１の半導体層（３１４、４１４）に絶縁層（４０４）を付着させる前記工程は、絶縁層（４０４）を真空圧含浸する工程を含む、請求項６に記載の方法。